## 科学研究費助成事業

研究成果報告書

科研費

平成 2 9 年 5 月 1 9 日現在



研究成果の概要(和文):鉄カルコゲナイド超伝導体FeSe1-xTex薄膜の基礎物性の評価と,FeSe薄膜をベースに した人工超格子薄膜の作製を行った.FeSeで見られた構造相転移はTe置換とともに抑制され,構造相転移が完全 に抑制されたTe量において,最も高い超伝導転移温度が得られることを明らかにした.また,(FeSe)-(FeTe)人 工超格子薄膜を作製した結果,周期構造を反映したサテライトピークを観測し,透過電子顕微鏡像でも周期的な 組成の変調を確認した.上部臨界磁場の異方性の結果は,本来障壁層であるFeTe層にSeが侵入することによって 超伝導化し,この層が人工超格子の超伝導を担っていることを示唆している.

研究成果の概要(英文):I investigated properties of FeSe1-xTex thin films and fabricated FeSe/FeTe superlattice thin films. In FeSe1-xTex films, structural transition temperature decreases with increasing x and the highest Tc is obtained at the composition where structural transition disappears.

In FeSe/FeTe superlattice films, x-ray diffraction patterns show clear satellite peaks demonstrating periodic stacking structures of FeSe and FeTe. The anisotropy of the upper critical field shows that the superconducting layer is not FeSe layer but FeTe layer because of the Se/Te interdiffusion at the interface.

研究分野:低温物理学

キーワード: 鉄系超伝導体 薄膜 人工超格子構造

#### 1.研究開始当初の背景

2008 年に LaFeAs(O,F)の超伝導が報告され て以来,鉄系超伝導体に関する研究が世界中 で盛んに行われてきた.特に,近年,注目度 の高い物質が鉄カルコゲナイド超伝導体 FeSe1-rTerである.この物質は鉄系超伝導体の 中で最も単純な結晶構造を持つ. 母物質の FeSe は低温で構造相転移を示すが,その際, 磁気秩序の形成を伴わない.これは他の鉄系 超伝導体にはない特徴であり, 軌道秩序(ネ マティック秩序)と超伝導との関連を議論す るのに適した系として,超伝導機構の解明を 目指した研究が盛んに行われている.また, FeSeの超伝導転移温度T。は常圧下では約8K 程度であるが,層間に様々な分子を挿入し層 間距離を拡大することで 45 K 程度まで上昇 することが報告されている.また SrTiO3基板 上に単原子層の FeSe 薄膜を作製すると,非 常に高い温度で超伝導ギャップとよく似た 構造が観測されている.超伝導を示唆する構 造が観測される温度は,100 K にも達すると いう報告もあるが,成膜を行なった超高真空 チャンバーの外で,電気抵抗率などの測定を 行うことが難しく,詳細な研究には至ってい ない状況であった.このように,鉄カルコゲ ナイド超伝導体は,超伝導機構解明,および, 超伝導転移温度の向上の両面において,非常 に重要な物質といえる.研究代表者も,この 鉄カルコゲナイド超伝導体に着目し, 良質な FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub>薄膜作製を目的に研究を行ってき た.その結果,バルク結晶では単相試料を作 製することができないと考えられてきた 0.1 < x < 0.4 の領域において,初めて相分離を抑 制した薄膜の作製に成功し,この系の完全な 相図を示した、この薄膜作製技術を生かして、 薄膜でしか作製することができない FeSe1-rTer 薄膜を用いた研究,そして,FeSe 層をベースとした人工超格子薄膜を用いた 物質開発研究を着想するに至った.

2.研究の目的

鉄カルコゲナイド超伝導体の薄膜作製の 技術を生かして,以下の2つの目的で研究を 行う.

(1) FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub> は,バルク試料では相分離が 存在するために,全組成領域に渡って単相の 単結晶試料を作製することができるのは薄 膜だけである.そこで,同物質の基礎的な物 性を測定し,Se に対する Te 置換の効果や, 構造相転移と超伝導との関係について明ら かにする.

(2)FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub>の薄膜作製の技術を生かして, 原子層単位で成長を制御することによって, X-FeSe または X-FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub>人工超格子薄膜 を作製する.ただし,X は障壁層である.人 工超格子構造を利用して,バルク試料ではこ れまでに報告ない,単位格子中に複数の伝導 面を有する構造や,伝導面の間隔を系統的に 変化させた構造を作製し,超伝導転移温度の 向上を目指す. 3.研究の方法

薄膜作製は全てパルスレーザー堆積(PLD) 法によって行った.X線回折によって,相の 同定,配向性の確認,および,積層周期や格 子定数の決定を行った.原子間力顕微鏡 (AFM)により表面状態の観察を,反射高速電 子線回折(RHEED)により成長モードの特定, 積層周期の決定を行った.ゼロ磁場下での電 気抵抗率の測定により,構造相転移温度や超 伝導転移温度を決定した.また,磁場中ので の電気抵抗率測定により,上部臨界磁場を見 積もった.断面透過電子顕微鏡(断面 TEM)に より,局所構造を観察し,エネルギー分散型 X線分析(EDX)によって,局所的な組成分析 を行った.

4.研究成果

(1) FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub>の完全な温度組成相図

フッ化カルシウム(CaF2)基板だけでなく, 酸化物であるランタン酸アルミニウム (LaAlO<sub>3</sub>, LAO と略記) 基板上にも相分離を 抑制した FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub> 薄膜を作製できることを 明らかにした LAO の場合は x = 0.4 付近で,  $CaF_2$ の場合はx = 0.2付近で,最も高い $T_c$ を 得た.これらの組成は従来,相分離がおこる とされていた領域である.さらに,電気抵抗 率を精密に測定したところ,Te量が少ない領 域では,微分抵抗に極小や極大が見られた. これは,バルク結晶では構造相転移に起因す るものであることが明らかとなっており, FeSe1-,Te, 薄膜でも構造相転移が見られるこ とがわかった.見積もった構造相転移温度  $(T_s)$ と  $T_c$ を Te 量 x に対してプロットした ものを図1に示す.T。は, x の増大に伴い減 少し, ある特定の Te 量で消失する. 構造相 転移が消失する Te 量は基板によって異なる



図 1. CaF<sub>2</sub>基板と LAO 基板上に作製した FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub> 薄膜の温度組成相図. $T_s$  は 構造相転移温度, $T_c$  は超伝導転移温度 (上付き文字の CaF<sub>2</sub>, LAO は基板材料 を指す.また, $T_c^{Bulk}$  はバルク結晶の超 伝導転移温度である).

ものの,ちょうど構造相転移が消失した組成 で最も高い超伝導転移温度が実現している. これは,超伝導と構造相転移とが競合関係に あることを示唆している.(5の雑誌論文の , , に相当)

(2) FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub> 薄膜の磁場中輸送特性,および,光学特性

 $CaF_2$  基板上に作製した  $FeSe_{1,x}Te_x$  薄膜の磁 場中の輸送特性を測定した.構造相転移が抑 制される x = 0.2 付近を境として, 上部臨 界磁場の値, 超伝導転移幅, ホール係 数の温度依存性,もまた劇的に変化すること を明らかにした.特に,ホール係数の振る舞 いの変化は,電子状態が大きく変化すること を示しており,構造相転移の有無とよく対応 している.(5の雑誌論文の , , に相 当)

また,母物質 FeSe の光学伝導度を測定した結果,構造相転移温度以下において,コヒ ーレントなキャリア密度が徐々に減少していく振る舞いを観測した.この結果は,他の 鉄系超伝導体とは異なるものである.(5の 雑誌論文の に相当)

(3)人工超格子薄膜 FeSe-X,または,X-FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub>の作製

障壁層 (X) の候補材料の検討

まず,障壁層 (X) の候補となりうる材料を 検討した.その条件は,(a) 超伝導を示さな い材料,(b)結晶構造が正方晶あるいは立方 晶,(c) FeSe に近い格子定数を持っているこ と,(d) 製膜温度が FeSe の製膜温度 (300-400) に近いこと (e) 絶縁性の高い材 料が好ましい、の5つが挙げられる.これら の条件を満たす可能性のある材料として、 FeSe と同じ PbO 構造を持つ ,(Fe,Co)Se, FeTe, FeS, SnO, ダイヤモンド構造をとる Ge, 閃亜 鉛構造を持つ ZnSe, 立方晶で半導体である FeS2などが挙げられる.これらを適当な基板 上にバッファー層として,成長させたのちに, FeSe や FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub> 薄膜を作製し, その超伝導 特性を評価することで,障壁層としてのポテ ンシャルを評価した.その結果,FeTe, (Fe,Co)Se が障壁層の候補となりうることを 明らかにした.

人工超格子薄膜 (FeSe)<sub>m</sub>-(FeTe)<sub>m</sub> の作製お よび物性測定

ー定の周期で,同じ層数ずつ FeSe と FeTe を積層した人工超格子薄膜(FeSe)<sub>m</sub>-(FeTe)<sub>m</sub> を 作製した.X線回折実験の結果,超周期構造 を示唆するサテライトピークを観測した.界 面の反射を無視した単純なステップモデル による計算の結果は,ほぼ狙い通りの積層周 期を持つ超格子薄膜が得られたことを示唆 している.また,透過電子顕微鏡(TEM)を 用いた断面像の観測から,一定間隔で Se と Te 濃度に変調は見られるものの,FeSe(FeTe) 層への Te(Se)の混入が見られることがわか った.電気抵抗率の温度依存性を測定した結 果,FeSeよりは高い温度で超伝導転移を観測 した.しかし,その超伝導転移温度 $T_c$ は FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub>の $T_c$ をよりも低い.断面 TEM の結 果から,界面においてセレンとテルルの相互 拡散の存在が確認されていることから,この 超伝導転移は,相互拡散により形成された FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub>相が担っている可能性を否定する ことはできない.その一方で,上部臨界磁場 の測定から求めた異方性パラメータは,各層 の厚さの増加に伴って増大しており,人工超 格子構造特有の振る舞いを観測したと言え る.(5の雑誌論文の に相当)

人工超格子薄膜 (FeSe)<sub>m</sub>-(FeTe)<sub>n</sub> (m: 固定) の作製および物性測定

FeSe 層の厚さを固定し, 障壁層 FeTe の厚 さを系統的に変化させた人工超格子薄膜 (FeSe)<sub>m</sub>-(FeTe)<sub>n</sub>(m: 固定)を作製した. 同様, X線回折像において超格子構造を反映したサ テライトピークを観測した.また,電気抵抗 率測定の結果,FeSeを単独で製膜した場合よ りは高い超伝導転移温度を有する薄膜を得 た.しかし, FeTe 層の厚さを変化させても, 超伝導転移温度の変化はほとんど見られな かった.磁場中での電気抵抗率測定から上部 臨界磁場の異方性を見積もったところ, FeTe 層の厚みを増大させるに連れて,異方性が小 さくなることがわかった.これは, FeSe 層が 超伝導を担っていると考えると,説明できな い振舞いである.一方, FeSe と FeTe との界 面における Seと Teの相互拡散によって,本 来障壁層となることを想定していた FeTe 層 が Se の侵入によって超伝導化し,この超格 子薄膜の超伝導を担っていると考えると,上 述の異方性の振る舞いを理解することが可 能である.

人工超格子薄膜 (FeSe)<sub>m</sub>-(FeTe)<sub>n</sub> (n:固定) の作製および物性測定

で得られた振る舞いを検証するために, FeTe 層の厚さを固定し,FeSe 層の厚さを系 統的に変化させた人工超格子薄膜 (FeSe)"-(FeTe)"(n:固定)を作製した.と同 様に,上部臨界磁場の異方性を見積もったと ころ,FeSe 層の厚さを増大させるに連れて, 異方性が増大することが明らかとなった.こ れはで予想した通り,界面でSeとTeが相 互拡散することによって,FeTe 層がFe(Se,Te) となることで超伝導層に変化し,この人工超 格子薄膜の超伝導を担っていると考えると 説明することができる.以上の結果から, FeTe を障壁層とすることは,相互拡散の問題 で困難であることが明らかとなった.

人工超格子薄膜 (FeSe)<sub>m</sub>-(Fe<sub>0.8</sub>Co<sub>0.2</sub>Se)<sub>n</sub> (m: 固定) の作製および物性測定

FeSe において, FeをCoで置換すると,超 伝導が急激に抑制される.そこで,超伝導を 示さない Fe<sub>0.8</sub>Co<sub>0.2</sub>Se を障壁層として,人工超 格子薄膜(FeSe)<sub>m</sub>-(Fe<sub>0.8</sub>Co<sub>0.2</sub>Se)<sub>n</sub>(m:固定)を作 製した.遷移金属元素の界面における相互拡 散は,カルコゲン元素と比べると,小さいも のと考えた.X線回折像を測定した結果,を 障壁層とした場合とは異なり,サテライトピ ークは見られなかった.これは,FeSe と Fe<sub>0.8</sub>Co<sub>0.2</sub>Seの格子定数の差が小さいことによ るものと思われる.また電気抵抗率の測定を 行なった結果,金属的な温度依存性は観測し たものの,超伝導転移は見られなかった.現 時点でこの原因は明らかではないが,界面で Co拡散が見られるか否かを検証するために, 透過電子顕微鏡による組成分析を行う必要 がある.

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計8件)

M. Nakajima, K. Yanase, F. Nabeshima, <u>Y.</u> <u>Imai</u>, A. Maeda, S. Tajima, "Gradual Fermi-surface modification in orbitally ordered state of FeSe revealed by optical spectroscopy", Phys. Rev. B, 査読有, 95 巻, 2017, 184502/1-5. DOI: 10.1103/PhysRevB.95.184502

<u>Yoshinori Imai</u>, Yuichi Sawada, Fuyuki Nabeshima, Daisuke Asami, Masataka Kawai, Atsutaka Maeda, "Control of structural transition in FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub> thin films by changing substrate materials", Sci. Rep., 査読有, 7 巻, 2017, 46653/1-6.

DOI: 10.1038/srep46653

F. Nabeshima, <u>Y. Imai</u>, A. Ichinose, I. Tsukada, A. Maeda, "Growth and transport properties of FeSe/FeTe superlattice thin films", Jpn. J. Appl. Phys., 查読有, 56 巻, 2017, 020308/1-4.

DOI: 10.7567/JJAP.56.020308

I. Tsukada, A. Ichinose, F. Nabeshima, <u>Y.</u> Imai, A. Maeda, "Origin of lattice compression of FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub> thin films on CaF<sub>2</sub> substrates", AIP Advances, 查読有, 6 巻, 2016, 095314/1-5. DOI: 10.1063/1.4963646

Y. Sawada, F. Nabeshima, D. Asami, R. Ogawa, <u>Y. Imai</u>, A. Maeda, "Transport properties of FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub> thin films under magnetic fields up to 8 T", Physica C, 查読有, 530 巻, 2016, 27-30. DOI: 10.1016/j.physc.2016.02.020

<u>Y. Imai</u>, Y. Sawada, D. Asami, F. Nabeshima, A. Maeda, "Superconducting properties of FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub> films with x = 0-0.4", Physica C, 查 読有, 530 巻, 2016, 24-26.

DOI: 10.1016/j.physc.2016.05.001

Y. Sawada, F. Nabeshima, <u>Y. Imai</u>, A. Maeda, "Investigation of Transport Properties for FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub> Thin Films under Magnetic Fields", J. Phys. Soc. Jpn., 査読有, 85 巻, 2016, 073703/1-4.

DOI: 10.7566/JPSJ.85.073703

#### DOI: 10.1063/1.4953337

今井良宗,澤田雄一,鍋島冬樹,前田京 剛,"鉄カルコゲナイド超伝導体の新しい電子 状態相図 - 薄膜化による相分離の抑制 -", 固体物理,査読有,50巻,2015,457-470.

#### [学会発表](計36件)

<u>Y. Imai</u>, F. Nabeshima, Y. Sawada, D. Asami, M. Kawai, A. Maeda, "Suppression of phase separation and whole phase diagram in  $\text{FeSe}_{1-x}\text{Te}_x$  thin films on LaAlO<sub>3</sub> substrates", American Physical Society March Meeting 2017, Mar. 14. 2017., Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, LA, USA

<u>**Yoshinori Imai**</u> (招待講演), "Suppression of phase separation & enhanced  $T_c$  in FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub> thin films", 2016 EMN Prague Meeting, June 23. 2016., Grandior Prague Hotel, Prague, Czech Republic

今井 良宗(招待講演),"相分離を抑制した鉄カルコゲナイド薄膜の超伝導",第57回 化合物新磁性材料専門研究会「新原理・新手 法による新規機能性材料の創出」,2016.6.15., 東京大学浅野キャンパス情報基盤センター (東京都文京区)

Fuyuki Nabeshima, Daisuke Asami, Yuichi Sawada, <u>Yoshinori Imai</u>, Masafumi Hanawa, Ataru Ichinose, Ichiro Tsukada, Atsutaka Maeda, "Fabrication and Transport Properties of FeSe/FeTe Superlattice Thin Films", 28th International Symposium on Superconductivity (ISS 2015), Nov. 17. 2015., Tower Hall Funabori, Tokyo, Japan.

<u>**Voshinori Imai**</u> (招待講演), "New Electronic Phase Diagram of Iron-Chalcogenide Superconductor ~ Suppression of Phase Separation using Film Fabrication ~", 28th International Symposium on Superconductivity (ISS 2015), Nov. 17. 2015., Tower Hall Funabori, Tokyo, Japan.

他 31 件

〔図書〕(計2件)

今井良宗,前田京剛,"鉄カルコゲナイド超 伝導体の超伝導転移温度の大幅な上昇",セ ラミックス,50巻,2015,721.

今井良宗, 澤田雄一, 浅見大亮, 鍋島冬樹, 前田京剛, "相分離を抑制した FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub> 薄膜の作製と超伝導転移温度の上昇", FSST ニュース, 147 巻, 2015, 7-12.

〔 産業財産権 〕
出願状況(計0件)

取得状況(計0件)

〔その他〕 ホームページ等 プレスリリース"鉄カルコゲナイド超伝導体の超伝導転移温度の謎を解明 構造相転移 と超伝導とは競合関係"

### 東北大学

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2017/04/press 20170421-01.html

## 東北大学大学院理学研究科

http://www.sci.tohoku.ac.jp/news/20170424-905 1.html

#### 東京大学総合文化研究科

http://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/topice/files/201604211800pressrelease.pdf

## マイナビニュース

http://news.mynavi.jp/news/2017/04/25/200/

#### 日本経済新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXLRSP443240 R20C17A4000000/

### 6.研究組織

(1) 研究代表者
 今井 良宗(IMAI, Yoshinori)
 東北大学・大学院理学研究科・講師
 研究者番号: 30435599

# (2) 研究協力者

前田 京剛 (MAEDA, Atsutaka) 東京大学・大学院総合文化研究科・教授 研究者番号:70183605 鍋島 冬樹 (NABESHIMA, Fuyuki) 東京大学・大学院総合文化研究科・助教 研究者番号:30782776